

PAT-NO: JP409231598A
DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 09231598 A
TITLE: OPTICAL PICKUP DEVICE
PUBN-DATE: September 5, 1997

INVENTOR-INFORMATION:
NAME
IIZUKA, GENICHI

ASSIGNEE-INFORMATION:
NAME COUNTRY
SONY CORP N/A

APPL-NO: JP08034094
APPL-DATE: February 21, 1996

INT-CL (IPC): G11B007/12, G11B007/09

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To easily remove short-circuited + and - terminals for preventing the electrostatic breakdown of a semiconductor laser element while the element is being carried in an optical pickup device constituted by arranging optical parts including the semiconductor laser element on a printed circuit board stuck to a substrate.

SOLUTION: A short land section 46 protruding to the outside from the side edge of a substrate 2 is provided in a printed circuit board 36 and short lands 47 and 48 connected to the +- terminals of a semiconductor laser element are formed on this short land section 46. During carrying, the short lands 47 and 48 is short-circuited with each other by soldering and during use, the short land section 46 is removed by bending this along the side edge of the substrate 2 and the short-circuiting between the short lands 47 and 48 is removed.

COPYRIGHT: (C)1997,JPO

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-231598

(43)公開日 平成9年(1997)9月5日

| (51)Int.Cl. ⁸ | 識別記号 | 序内整理番号 | F I | 技術表示箇所 |
|--------------------------|------|--------|---------|--------|
| G 1 1 B | 7/12 | | G 1 1 B | |
| | 7/09 | | 7/09 | A |

審査請求 未請求 請求項の数 2 O L (全 14 頁)

(21)出願番号 特願平8-34094

(22)出願日 平成8年(1996)2月21日

(71)出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72)発明者 飯塚 源一

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

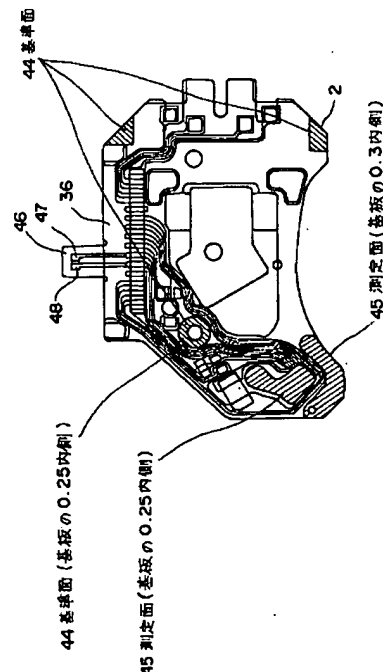
(74)代理人 弁理士 小池 晃 (外2名)

(54)【発明の名称】 光学ピックアップ装置

(57)【要約】

【課題】 基板2に貼着されたプリント基板36上に半導体レーザ素子を含む光学部品を配置して構成する光学ピックアップ装置において、搬送中における半導体レーザ素子の静電破壊を防止するための＋端子のショートが容易に外せるようにする。

【解決手段】 プリント基板36に基板2の側縁よりも外方側に突出したショートランド部46を設け、このショートランド部46上に半導体レーザ素子の＋端子に接続されたショートランド47、48を形成しておく。搬送中は、ショートランド47、48間を半田によりショートさせておき、使用時には、ショートランド部46を基板2の側縁に沿って折曲させて取り除き、ショートランド47、48間のショートを外す。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1の基板部と、

主面部にプリント配線パターンが形成され、上記第1の基板部の上面部にこの第1の基板部に沿って取付けられた第2の基板部と、

上記第2の基板部の上面部に配設された発光素子とを備え、

上記第2の基板部は、上記第1の基板部の側縁部よりも外方側に突出したショートランド部を有し、このショートランド部上に、上記発光素子の電源供給端子が接続された配線パターンに連続する一方のショートランドと、この一方のショートランドに近接して、該発光素子の接地端子が接続された配線パターンに連続する他方のショートランドとを有している光学ピックアップ装置。

10

【請求項2】 第2の基板部は、ガラス-エポキシプリント基板であることとなされた請求項1記載の光学ピックアップ装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

20

【発明の属する技術分野】本発明は、光ディスクの如き光学記録媒体に対して情報信号の記録再生を行う光学ピックアップ装置に関する技術分野に属する。

【0002】

【従来の技術】従来、光ディスクの如き光学記録媒体が提案され、この光ディスクより情報信号の読み取りを行う光学ピックアップ装置が提案されている。

【0003】この光学ピックアップ装置は、半導体レーザ素子の如き光源と、この光源より発せられる光束を導く複数の光学部品とを有して構成されている。この光源より発せられた光束は、対物レンズにより、上記光ディスクの信号記録層上に集光される。

【0004】そして、上記信号記録層上に集光された光束は、この信号記録層により反射され、上記対物レンズに戻る。上記対物レンズに戻った光束は、ビームスプリッタにより、上記光源に戻る光路より分割され、フォトダイオードの如き光検出器により受光される。この光検出器より出力される光検出力は、上記光ディスクに記録された情報信号の読み取り信号となる。

【0005】このような光学ピックアップ装置を有して構成される光ディスク再生装置においては、上記光ディスクが中心部分を保持されて回転操作されるとともに、該光学ピックアップ装置が上記対物レンズを該光ディスクの主面部に対向させた状態に支持される。この光学ピックアップ装置は、上記光ディスクの内外周に亘って移動操作されることにより、この光ディスクの信号記録層の全面に亘って、情報信号の読み取りを行うことができる。

【0006】このような光学ピックアップ装置として、1枚の基板部上に上記半導体レーザ素子、上記光検出器、上記ビームスプリッタ及び対物レンズ駆動機構を配

2

設し、これら素子及び光学部品を該基板部に取付けられるカバー部材（シェルカバー）によって覆って構成したものが提案されている。

【0007】この光学ピックアップ装置においては、上記半導体レーザ素子より発せられた光束は、上記ビームスプリッタを介して、上記対物レンズ駆動機構により支持された対物レンズに入射されて、上記光ディスクの信号記録層上に集光される。そして、この光束は、上記信号記録層により反射され、上記対物レンズ及び上記ビームスプリッタを介して、上記光検出器により受光される。

【0008】上記対物レンズ駆動機構は、上記対物レンズを支持するとともに、この対物レンズを、この対物レンズの光軸方向及びこの光軸方向に直交する方向に移動操作する機構である。この対物レンズ駆動機構は、上記光ディスクに記録された情報信号の読み取り信号に応じて上記対物レンズを移動操作することによって、この対物レンズを該光ディスクの回転に伴う偏心やいわゆる面振れに追従させて移動させ、この対物レンズにより形成される上記光束の集光点が、常に、該光ディスクの信号記録層の表面部の記録トラック上に形成されるようにする。

【0009】このような光学ピックアップ装置においては、上記半導体レーザ素子を、上記基板部上の所定の位置に正確に位置決めして取付ける必要がある。また、上記対物レンズ駆動機構は、上記基板部上において、上記半導体レーザ素子の位置を基準として正確に位置決めして取付ける必要がある。

30

【0010】そして、このような光学ピックアップ装置においては、上記カバー部材に、上記光ディスク再生装置において支持される被支持部が設けられている。したがって、上記カバー部材は、上記基板部に対して、正確に位置決めされて取付けられる必要がある。また、このカバー部材は、外方側より伝播する振動や衝撃により上記基板部に対して移動しないように、すなわち、この基板部に対していわゆるガタのない状態に取付けられる必要がある。

【0011】

40

【発明が解決しようとする課題】ところで、上述のような光学ピックアップ装置において、上記半導体レーザ素子は、静電気によって破壊され易い。すなわち、この半導体レーザ素子は、電源供給端子とグランド（GND）端子との間に、静電気により極めて短い時間内に高電圧が印加されることにより、いわゆる静電破壊を起こす。

【0012】この光学ピックアップ装置が上記光ディスク再生装置内に組み込まれた状態においては、上記半導体レーザ素子の電源供給端子とグランド端子との間がこの光ディスク再生装置の電源供給回路を介してクローズされるので、この半導体レーザ素子が静電破壊を生ずる虞れはない。

【0013】しかし、上記光学ピックアップ装置を単体で輸送、搬送する場合には、上記半導体レーザ素子の静電破壊が生じ易い。

【0014】そのため、従来、上記光学ピックアップ装置を単体で輸送、搬送する場合には、上記半導体レーザ素子の電源供給端子とグランド端子との間を半田付けにより短絡（ショート）させておくこととしている。

【0015】このように、上記半導体レーザ素子の電源供給端子とグランド端子との間を半田付けにより短絡させることは、この光学ピックアップ装置の製造を煩雑なものとし、また、この光学ピックアップ装置を上記光ディスク再生装置に組み込むときには該半田付けを取り外さなければならないため、該光ディスク再生装置の製造を煩雑なものとしている。

【0016】そこで、本発明は、上述の実情に鑑みて提案されるものであって、光学ピックアップ装置単体での輸送、搬送中における半導体レーザ素子の静電破壊が確実に防止されるとともに、製造が容易化され、さらに、光ディスク再生装置への組み込みが容易化された光学ピックアップ装置の提供という課題を解決しようとするものである。

【0017】

【課題を解決するための手段】上述の課題を解決するため、本発明に係る光学ピックアップ装置は、第1の基板部と、主面部にプリント配線パターンが形成され該第1の基板部の上面部にこの第1の基板部に沿って取付けられた第2の基板部と、この第2の基板部の上面部に配設された発光素子とを備え、上記第2の基板部は、上記第1の基板部の側縁部よりも外方側に突出したショートランド部を有し、このショートランド部上に、上記発光素子の電源供給端子が接続された配線パターンに連続する一方のショートランドと、この一方のショートランドに近接して、該発光素子の接地端子が接続された配線パターンに連続する他方のショートランドとを有しているものである。

【0018】また、本発明は、上記光学ピックアップ装置において、上記第2の基板部は、ガラスエポキシプリント基板であることとしたものである。

【0019】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら説明する。

【0020】本発明に係る光学ピックアップ装置は、図1に示すように、光学記録媒体である光ディスク101の信号記録層102の表面部に光束を集光させて照射し、この光束に反射光束に基づいて、該光ディスク101に記録された情報信号の読み取りを行う装置である。

【0021】この光学ピックアップ装置を有して構成される光ディスク再生装置においては、上記光ディスク101が中心部分を保持されて回転操作されるとともに、該光学ピックアップ装置が上記光束を集光させる対物レ

ンズ20を該光ディスク101の主面部に対向させた状態に支持される。そして、この光学ピックアップ装置は、上記光ディスク101の内外周に亘って移動操作されることにより、この光ディスク101の信号記録層の全面に亘って、情報信号の読み取りを行うことができる。

【0022】この光学ピックアップ装置は、1枚の基板部2、36上に、半導体レーザ素子、光検出器、ビームスプリッタ及び上記対物レンズ20を支持する対物レンズ駆動機構6を配設し、これら素子及び光学部品を該基板部2、36に取付けられるカバー部材であるシェルカバー30によって覆って構成したものである。

【0023】上記基板部2、36は、第1の基板部であるベース基板2と、このベース基板2の上面部に取付けられた第2の基板部となるプリント基板36とにより構成されている。

【0024】上記ベース基板2は、鉄板により形成されている。また、上記プリント基板36は、種々の絶縁材料よりなる基材部と、この基材部の主面部上に所定の形状を有して形成された銅箔からなるプリント配線パターンと、この配線パターンを覆うレジスト膜とを有して構成されている。

【0025】上記プリント基板36は、図2乃至図5に示すように、上記ベース基板2の上面部の一部を上方側に露出させた状態でこのベース基板2の上面部に該ベース基板2に沿って取付けられている。このベース基板2の上方側への露出部は、基準面44となる。

【0026】また、上記プリント基板36は、上記ベース基板2の上面部の縁部より外方側に食み出した鋸部分50を有している。この鋸部分50は、図2及び図3に示すように、上記ベース基板2に設けられた欠損部38、39上を上記プリント基板36が覆うことにより形成されている。

【0027】なお、上記基準面44と上記鋸部分50とは、図5に示すように、隣接させて設けてもよい（なお、図5中において括弧を付した数字は、寸法の例を示したものであり、単位はmmである）。

【0028】上記プリント基板36上には、光学部が配設されている。この光学部は、上記プリント基板36上に固定して配設された発光素子となる半導体レーザ素子10と、受光素子となる第1及び第2の光検出器（フォトダイオード）14a、14bと、該半導体レーザ素子10より発せられたレーザ光束を上記光ディスク101の信号記録層102の表面部に集光させる光学部品となる対物レンズ20とを有して構成されている。

【0029】上記半導体レーザチップ10及び上記各光検出器14a、14bは、図9に示すように、同一の半導体基材部13上に配設されることにより、レーザカバー（L/C）3を構成している。すなわち、上記半導体基材部13上には、ヒートシンク11を介して、上記半

導体レーザ素子10が配設されている。また、上記第1及び第2の光検出器14a、14bは、それぞれ複数の受光面に分割された状態で、上記半導体基材部13上に形成されている。

【0030】そして、このレーザカプラ3においては、上記各光検出器14a、14b上に位置して、ビームスプリッタプリズム12が配設されている。このビームスプリッタプリズム12は、上記半導体基材部13の上面部に対して所定の傾斜角を有する斜面部であるビームスプリッタ面12Rを、上記半導体レーザ素子10側に向

10 けている。
【0031】上記レーザカプラ3は、上記プリント基板36上に、上記半導体基材部13の上面部を該プリント基板36の上面部に対して平行として、接着によって固定される。

【0032】このレーザカプラ3において、上記半導体レーザ素子10は、上記ビームスプリッタ面12Rに向けてレーザ光束を発する。この半導体レーザ素子10より発せられたレーザ光束は、上記ビームスプリッタ面12Rにより反射され、上記半導体基材部13に対する垂

30 直上方に射出される。
【0033】上記レーザカプラ3より射出されたレーザ光束は、このレーザカプラ3の上方側を覆うようにして上記プリント基板36上に配設された反射ミラー4により反射されて、このプリント基板36の上面部に平行な方向に偏向される。そして、このレーザ光束は、上記プリント基板36上に上記対物レンズ20の下方に位置して配設された反射プリズム5により反射され、該プリント基板36の上面部に対する垂直上方側に偏向される。上記対物レンズ20は、後述する対物レンズ駆動機構6により、上記プリント基板36の上方側にこのプリント基

30 板36より離間して支持されている。
【0034】上記反射プリズム5を介して上記対物レンズ20に入射したレーザ光束は、この対物レンズ20により、上記光ディスク101の信号記録層102の表面上に集光される。

【0035】そして、上記信号記録層102の表面上に集光されたレーザ光束は、この信号記録層102により反射され、上記対物レンズ20に戻る。上記対物レンズ20に戻った反射光束は、上記反射プリズム5及び上

40 記反射ミラー4を介して、上記ビームスプリッタ面12Rに戻る。
【0036】上記ビームスプリッタ面12Rに戻った反射光束は、このビームスプリッタ面12Rを透過して上記ビームスプリッタプリズム12内に入射することにより、上記半導体レーザ素子10に戻る光路より分割され、上記第1の光検出器14aにより受光される。また、この反射光束は、上記第1の光検出器14aの表面部及び上記ビームスプリッタプリズム12の内面部により反射されて、上記第2の光検出器14bにも受光され

る。

【0037】上記各光検出器14a、14bより出力される光検出力に基づいて、上記光ディスク101に記録された情報信号の読み取り信号(RF信号)、上記対物レンズ20による上記光束の集光点と上記信号記録層102の表面部との光軸方向のずれ(フォーカスエラー)を示すフォーカスエラー信号(FE信号)、及び、該集光点と該信号記録層102の表面部に形成された記録トラックとの光軸及び該記録トラックに直交する方向のずれ(トラッキングエラー)を示すトラッキングエラー信号(TE信号)が算出される。

【0038】すなわち、上記読み取り信号(RF信号)は、上記各光検出器14a、14bの各光検出力の和として得られる。また、上記フォーカスエラー信号(FE信号)は、上記各光検出器14a、14bの各光検出力の差として得られる。

【0039】さらに、上記トラッキングエラー信号(TE信号)は、上記第1の光検出器14aの一側側の受光面からの光検出力(A)及び上記第2の光検出器14aの他側側の受光面からの光検出力(D)の和と、該第1の光検出器14aの他側側の受光面からの光検出力(B)及び該第2の光検出器14aの一側側の受光面からの光検出力(C)の和との差((A+D)-(B+C))として得られる。

【0040】なお、上記各光検出器14a、14bにおいて、一側側の受光面と他側側の受光面との分割線は、図10に示すように、上記光ディスク101における記録トラックの接線方向Tに対して、45°の角度をなすようになされている。上記記録トラックは、上記信号記録層102の表面上において、上記光ディスク101の中心部を中心とする略々同心円状をなす螺旋状に形成されている。

【0041】そして、上記プリント基板36上には、上記対物レンズ駆動機構6が配設されている。この対物レンズ駆動機構6は、図21に示すように、上記対物レンズ20を移動操作可能に支持するレンズボビン21とこのレンズボビン21を移動操作する磁気回路部とを有して構成されている。

【0042】この対物レンズ駆動機構6は、上記対物レンズ20を支持するとともに、この対物レンズ20を、この対物レンズ20の光軸方向及びこの光軸方向に直交する方向に移動操作する機構である。

【0043】この対物レンズ駆動機構6は、上記フォーカスエラー信号及びトラッキングエラー信号に応じて上記対物レンズ20を移動操作することによって、この対物レンズ20を該光ディスク101の回転に伴う偏心やいわゆる面振れに追従させて移動させ、この対物レンズ101により形成される上記光束の集光点が、常に、上記記録トラック上に形成されるようにする。

50 【0044】この対物レンズ駆動機構6は、上記プリン

ト基板36上において移動調整後にこのプリント基板36に対して固定される調整プレート54を有して構成されている。この調整プレート54上には、支持ブロック6eが固定して配設されている。この支持ブロック6eは、4本の板バネ22, 23, 24, 25を介して、上記レンズボビン21を支持している。このレンズボビン21には、上記対物レンズ20が取付けられている。このレンズボビン21は、上記各板バネ22, 23, 24, 25の弾性変位により、上下及び左右方向の2軸方向に移動可能となされている。

【0045】また、上記レンズボビン21には、上記磁気回路部を構成するコイルボビン26が取付けられている。このコイルボビン26には、フォーカスコイル26aが外周面部に巻回されるとともに、略々円環状に巻回された一対のトラッキングコイル26bが取付けられている。

【0046】そして、上記プリント基板36上には、上記調整プレート54に連動して移動調整される可動ヨーク60が配設されている。この可動ヨーク60は、図21乃至図23に示すように、被結合部となる一対の係合突起(ダボ)63, 64を有しており、これら係合突起63, 64を上記調整プレート54の前端側のアーム部56, 58に設けられた穴59及び長穴57に嵌入係合させることにより、該調整プレート54の移動調整に連動して移動調整される。この可動ヨーク60は、上記プリント基板60の上面部に沿う2次元方向に移動調整される。

【0047】この可動ヨーク60は、上方側に突設された一対のヨーク27a, 27bを有している。これらヨーク27a, 27bの一方には、マグネット28が取付けられている。これらマグネット28及び各ヨーク27a, 27bは、上記可動ヨーク60を介して、磁気回路を形成している。この磁気回路においては、上記マグネット28と他方のヨーク27aとの間が、磁気ギャップ部となっている。

【0048】上記コイルボビン26は、上記レンズボビン21に取付けられることにより、上記フォーカスコイル26aの一部及び上記各トラッキングコイル26bの一部を上記磁気回路の磁気ギャップ内に位置させている。

【0049】すなわち、上記フォーカスコイル26aに上記フォーカスエラー信号に応じた駆動電流が供給されることにより、このフォーカスコイル26aは、上記磁気ギャップ部内の磁束により電磁力を受け、上記レンズボビン21を上記対物レンズ20の光軸方向(上下方向)に移動させる。また、上記トラッキングコイル26bに上記トラッキングエラー信号に応じた駆動電流が供給されることにより、このトラッキングコイル26bは、上記磁気ギャップ部内の磁束により電磁力を受け、上記レンズボビン21を上記対物レンズ20の光軸に直

交する方向(左右方向)に移動させる。

【0050】そして、この光学ピックアップ装置においては、上記基板部2, 36に対して、上記シェルカバー30が取付けられている。

【0051】このシェルカバー30は、図6乃至図8に示すように、上記基板部2, 36上に取付けられることにより上記光学部を覆うことができる形状を有して、PPS樹脂や亜鉛ダイカストの如き寸法精度及び剛性の高い材料により、例えば射出成形の如き手段により形成されている。

【0052】このシェルカバー30は、上記基板部2, 36に対向する下面部分に、下方側に向けて突設された第1の当接部である複数の当接杆43, 43を有している。また、このシェルカバー30は、側方側部分に、第2の当接部である一対の当接爪42, 42を有している。これら当接爪42, 42は、上記シェルカバー30の下面部より下方側に向けて突設された支持杆41, 41の下端側に、側方に向けて突設されている。

【0053】上記各当接杆43, 43の下端部と上記各当接爪42, 42の上面部とは、図8に示すように、互いに同一平面P上に位置する関係となっている。

【0054】そして、このシェルカバー30が上記基板部2, 36に取付けられるとき、上記当接杆43, 43の下端部は、図2及び図3に示すように、上記ベース基板2の上面部の上方側への露出部分である上記基準面44に当接される。また、このシェルカバー30が上記基板部2, 36に取付けられるとき、上記各当接爪42, 42の上面部は、図2及び図3に示すように、上記プリント基板36の鋸部分50の下面部に当接される。

【0055】上記プリント基板36の下面部は上記ベース基板2の上面部に沿っているため、これらプリント基板36の下面部及びベース基板2の上面部は、同一平面上に位置している。そして、上記各当接杆43, 43の下端部及び上記各当接爪42, 42の上面部は互いに同一平面上に位置しているため、該各当接杆43, 43の下端部が上記基準面44に当接され該各当接爪42, 42の上面部が上記鋸部分50の下面部に当接されることにより、上記シェルカバー30は、上記基板部2, 36に対して、上下方向(すなわち、この基板部2, 36に対する接離方向)について、正確に位置決めされる。

【0056】そして、上記シェルカバー30は、図2に示すように、上記基板部2, 36に形成されたネジ挿通孔40に下方側より挿通されたネジ37を、下方側に向けて形成されたネジ穴に螺入されることにより、該基板部2, 36に対して取付けられる。

【0057】そして、上記シェルカバー30は、上面部に、上記対物レンズ20を上方側に臨ませるための透孔31を有している。

【0058】上記シェルカバー30は、成形型を用いた成形により形成する場合において、上記平面Pをパーテ

ィングライン(型割部)上に位置する平面であることとして形成することにより、上記各当接杆43、43の下端部及び上記各当接爪42、42の上面部を正確に同一平面上に位置させて形成することができる。

【0059】なお、平板状の部材である基板部にカバー部材を取付けるための構成として、図27に示すように、該カバー部材130の側縁部分に当接杆143及び引っ掛け爪141を一体的に設け、該基板部112の上面部の側縁部近傍に該当接杆143の下端部を当接させるとともに、該引っ掛け爪141を該基板部112の側縁部に引っ掛けるものが考えられる。上記引っ掛け爪141の下端側には、上記当接杆143に向けて爪部142を突設しておく。

【0060】このような構成により上記カバー部材130を上記基板部112に取付ける場合には、上記引っ掛け爪141は、該カバー部材130が該基板部112に取付けられるときに、該基板部112の外周縁よりも外側に弾性変形される。したがって、この場合には、上記カバー部材130は、上記引っ掛け爪141の弾性変形が可能となる程度の弾性を有する材料により形成されている必要がある。

【0061】このような弾性を有する材料、例えば、ABS樹脂の如き合成樹脂材料は、寸法精度が低く、また、熱変形を起こす温度が低いため、上記被支持部が設けられるカバー部材を形成する材料として不適切である。

【0062】上記カバー部材は、寸法精度が高いが弾性を有しないPPS樹脂や亜鉛ダイカストにより形成されているので、上述の如き引っ掛け爪を設ける構成により上記基板部に取付けることはできない。

【0063】また、上記基板部112にカバー部材130を取付けるための構成としては、図28に示すように、該カバー部材130の側縁部分に上下一対の支持片144、145を設け、該基板部112の側縁部近傍を該各支持片144、145間に挟むようにしたものが考えられる。

【0064】このような構成においては、上記基板部112の厚さの精度と上記各支持片144、145の位置及び厚さの精度とに依り、これら基板部112と各支持片144、145との間は、圧入になるか、または、遊嵌(ガタ)になるかのいずれかであり、上記シェルカバー30を上記基板部2、36に取付ける構成として不適当である。

【0065】そして、上記シェルカバー30は、一側側部分に被支持部である係合溝32を有している。この係合溝32は、上記シェルカバー30の一側部より側方側に向けて一対の結合片33、34が突設されることにより、これら結合片33、34の間の部分として形成されている。また、このシェルカバー30の他側側部分には、被支持部であるスラストスリーブ部35が形成され

ている。このスラストスリーブ部35は、直線円柱状の透孔として形成されている。

【0066】上記光ディスク再生装置においては、図1に示すように、上記スラストスリーブ部35に該光ディスク再生装置の支持シャフト104が挿通され、上記係合溝32に該光ディスク再生装置の支持片部103が嵌入係合することにより、この光学ピックアップ装置は、所定の位置に支持される。

【0067】そして、上記プリント基板36は、図4、図18及び図19に示すように、上記ベース基板2の側縁部よりも外方側に突出したショートランド部46を有している。このショートランド部46上には、上記半導体レーザ素子10の電源供給端子(+端子)が接続されたプリント配線パターンに連続する一方のショートランド47と、この一方のショートランド47に近接して、該半導体レーザ素子10の接地端子(グランド(GND)端子)が接続されたプリント配線パターンに連続する他方のショートランド48とが形成されている。

【0068】これら各ショートランド47、48は、この光学ピックアップ装置の単体での輸送、搬送中において、半田付け等により、互いに短絡(ショート)される。すなわち、この状態では、上記半導体レーザ素子10の電源供給端子と接地端子とが短絡された状態となっており、この半導体レーザ素子10の静電破壊が防止される。

【0069】そして、この光学ピックアップ装置を使用するとき、すなわち、この光学ピックアップ装置を上記光ディスク再生装置に組み込むときには、図20に示すように、上記ショートランド部46を上記ベース基板2の側縁部に沿って折り取ることにより、上記半導体レーザ素子10の電源供給端子と接地端子との短絡を解除することができる。

【0070】上記プリント基板36は、上記ショートランド部46の折り取りのし易さを考えると、ガラスエポキシプリント基板が適しており、厚さは0.2mm程度が適当である。

【0071】なお、上記プリント基板36上には、図10及び図17に示すように、上記各信号(RF信号、FE信号、TE信号)の取り出し、上記半導体レーザ素子10への電源供給、及び、上記対物レンズ駆動機構への駆動電流の供給のためのコネクタ53が設けられている。

【0072】そして、この光学ピックアップ装置においては、上記基板部2、36は、図10及び図11に示すように、上記半導体レーザ素子10が配設された位置(すなわち、上記レーザカプラ3が取付けられた位置)と上記対物レンズ駆動機構6が配設された位置との間に位置する屈曲変位部(ベース基板曲げ位置)52において、主面部方向(上下方向)への屈曲変位が可能となされている。

11

【0073】この光学ピックアップ装置においては、このような上記基板部2、36の屈曲変位によって、上記レーザカプラ3の上記対物レンズ駆動機構6に対する傾きの調整が可能となされている。

【0074】すなわち、図10に示すように、上記屈曲変位部52と上記レーザカプラ3が取付けられた側の側縁部までの距離が10mm乃至11mmであるとする、図12に示すように、この側縁部を上方側、または、下方側に0.1mm移動するだけ該屈曲変位部52を屈曲させると、

$$\sin^{-1}(0.1/11) = 0.52^\circ$$

より、該レーザカプラ3を±0.52°に亘って傾き調整することができる。このとき、上記基板部2、36を屈曲させる方向は、EFバランス（上記フォーカスエラー信号の中立点と上記読み取り信号におけるジッタの最良状態とのずれの方向）の極性（+側、-側）に応じて定めておくことができる。

【0075】そして、上記基板部2、36は、上記光ディスク再生装置においては、上記屈曲変位部52よりも上記対物レンズ駆動装置6が配設された側の部分を基準として、位置決め保持される。すなわち、この基板部2、36は、上記屈曲変位部52よりも上記対物レンズ駆動装置6が配設された側の部分において、上記シェルカバー30に対して位置決めされる。したがって、上記基板部2、36を屈曲させることによる調整は、上記光ディスク再生装置の基準面に対して上記レーザカプラ3が傾けられる状態で行われる。

【0076】なお、上記ベース基板2は、鉄板により形成されることが好ましい。アルミニウム（AL）では屈曲させることにより折れる虞れがあり、亜鉛（Zn）では屈曲させることによりクリープを生ずる虞れがあり、また、ステンレス（Sus）では屈曲させてもスプリングバックにより戻ってしまい高精度の調整ができないためである。

【0077】なお、この光学ピックアップ装置における部品精度及びマウント精度の例を、図13乃至図16により、以下に挙げる。

【0078】この光学ピックアップ装置においては、上記対物レンズ20より射出される主光線の位置は、上記シェルカバー30の位置を基準として、±0.3mm以内を目標としている。また、この光学ピックアップ装置においては、上記主光線の倒れは、上記シェルカバー30の位置を基準として、±0.5°以内を目標としている。

【0079】そして、上記基板部2、36と上記シェルカバー30との位置ずれは、X軸方向（該基板部2、36の上面部及び上記記録トラックに沿う方向）及びY方向（該基板部2、36の上面部に沿い上記記録トラック*

$$\sqrt{((0.32)^2 + (0.2)^2 + (0.1)^2 + (0.1)^2 + (0.13)^2)} = 0.42^\circ$$

12

*に直交する方向）について、それぞれ±0.05mm以内である。また、このシェルカバー30の上記基板部2、36に対する高さ方向のずれは、±0.05mm以内である。したがって、上記基板部2、36と上記シェルカバー30との傾きの誤差は、図13に示すように、X方向について、

$$\sin^{-1}(0.05/22) = 0.13^\circ$$

Y方向について、

$$\sin^{-1}(0.05/15) = 0.19^\circ$$

となる。ただし、X方向についての上記基準面44同士の間隔が22mmで、Y方向についての上記基準面44同士の間隔が15mmである場合においてである。

【0080】そして、上記基板部2、36における上記対物レンズ駆動機構6の位置の基準となる基準穴の位置ずれの精度は、X方向、Y方向ともに、±0.05mm以内である。また、上記基板部2、36の上面部の平面度は、図14に示すように、±0.02mm以内である。上記対物レンズ20の光軸と上記半導体レーザ素子10（上記レーザカプラ3）との距離を10mmとすると、この半導体レーザ素子10が取付けられる部分の傾きは、X方向について、

$$\sin^{-1}(0.02/10) = 0.10^\circ$$

Y方向について、

$$\sin^{-1}(0.02/10) = 0.10^\circ$$

となる。

【0081】次に、上記反射ミラー4及び上記反射プリズム5の位置精度を考えると、上記基板部2、36に対する位置ずれが、X方向、Y方向ともに、±0.05mm以内であり、これらの間のスパンの誤差は、±0.1mm以内である。上記反射ミラー4の基板部2、36への取付け精度は、図15に示すように、±0.2°以内であり、この反射ミラー4及び上記反射プリズム5間の平行度は、±0.1°以内である。

【0082】そして、上記レーザカプラ3の上記基板部2、36に対する位置ずれは、X方向、Y方向ともに、±0.05mm以内である。また、上記レーザカプラ3の上記基板部2、36に対する浮きは、図16に示すように、±0.01mm以内である。したがって、ディスクレーザカプラ3の上記基板部2、36に対する傾きは、X方向について、

$$\sin^{-1}(0.01/1.8) = 0.32^\circ$$

Y方向について、

$$\sin^{-1}(0.01/3.4) = 0.17^\circ$$

となる。ただし、X方向についての上記レーザカプラ3の長さが1.8mmで、Y方向についての上記レーザカプラ3の長さが3.4mmである場合においてである。

【0083】ここで、上記主光線のX方向についての倒れを計算すると、

13

14

また、上記主光線のY方向についての倒れを計算する * *と、

$$\sqrt{(0.17)^2 + (0.2)^2 + (0.1)^2 + (0.1)^2 + (0.19)^2} \\) = 0.35^\circ$$

そして、上記主光線のX方向についての位置ずれを計算※ ※すると、

$$\sqrt{(0.05)^2 + (0.05)^2 + (0.1)^2 + (0.05)^2 + (0.05)^2 + (23 \times \sin 0.42^\circ)^2} = 0.21 \text{ mm}$$

次に、上記主光線のY方向についての位置ずれを計算★ ★すると、

$$\sqrt{(0.05)^2 + (0.05)^2 + (0.05)^2 + (0.05)^2 + (23 \times \sin 0.35^\circ)^2} = 0.17 \text{ mm}$$

となる。この結果により、上記主光線のX方向についての倒れ(0.42°)が、上記目標値の±0.5°に接近しており、この項目についての不良率の増大が予想される。

【0084】この光学ピックアップ装置においては、上記基板部2、36の屈曲変位による調整によって、上記主光線のX方向についての倒れを修正することができ、不良率の減少を実現できる。

【0085】次に、この光学ピックアップ装置の組立及び調整の手順について説明する。

【0086】この光学ピックアップ装置を組み立てるには、まず、上記基板部2、36上の所定の位置に、上記レーザカプラ3を接着により固定して配設する。

【0087】次に、上記対物レンズ20が取付けられたレンズボビン21を上記各板バネ22、23、24、25を介して移動操作可能に支持している調整プレート54を、上記基板部2、36上に配設する。

【0088】そして、上記調整プレート54の上記基板部2、36に対する位置を調整することにより、上記レンズボビン21の位置を上記半導体レーザ素子10に対する所定位置とする。

【0089】上記レンズボビン21の位置を上記半導体レーザ素子10に対する所定位置とする調整は、上記光ディスク101に記録されている情報信号を読み取り、上記読み取り信号(RF信号)のレベル及びジッタ、E/Fバランス(上記フォーカスエラー信号の中立点と上記読み取り信号におけるジッタの最良状態とのずれの量)とが最良となる位置を探すことにより行う。

【0090】この調整プレート54の位置調整は、上記基板部2、36上において3次元方向に移動及び回転(傾き)させることにより行われる。

【0091】上記調整プレート54は、上記レンズボビン21の位置が上記半導体レーザ素子10に対する所定位置となった状態で、図23に示すように、後端側部分55を上記プリント基板36に対して半田66により半田付けされることにより、上記基板部2、36に対して固定される。

【0092】このような上記調整プレート54の調整により、上記対物レンズ駆動機構6は、上記対物レンズ20を上記半導体レーザ素子10の位置を基準とした最良の位置にて支持する状態に調整される。

10 ☆【0093】そして、上記ヨーク27a、27bを上記レンズボビン21の位置、すなわち、上記コイルボビン26の位置を基準として位置決めし、上記基板部2、36上に配設する。

【0094】上記各ヨーク27a、27bは、上述したように、上記可動ヨーク60を介して連結されて上記基板部2、36上に配設され、この基板部2、36の上面部に沿う2次元方向に移動可能となされている。また、上記可動ヨーク60は、この基板部2、36上における位置調整を行うための被結合部となる係合突起(ダボ)63、64を有しており、これら係合突起63、64を介して、上記調整プレート54に対して連結されている。

【0095】すなわち、上記各ヨーク27a、27bは、上記調整プレート54の上記基板部2、36上における移動の該基板部2、36の上面部に沿う2次元方向の成分に追従して、この基板部2、36上を移動される。したがって、これらヨーク27a、27bの上記コイルボビン26の位置を基準とする位置決めは、上記調整プレート54の移動調整と同時に行われる。

30 【0096】そして、上記各ヨーク27a、27bは、上記基板部2、36の上面部上における位置を、上記半導体レーザ素子10を基準として位置調整されたレンズボビン21の位置を基準として定められた状態で、該基板部2、36に対して固定される。これらヨーク27a、27bの上記基板部2、36に対する固定は、上記可動ヨーク60に設けられたネジ挿通孔61、62に挿通させたネジ65、65を該基板部2、36のネジ穴に螺入させることにより行う。

40 【0097】このような上記調整プレート54及び上記可動ヨーク60の調整により、上記対物レンズ駆動機構6は、上記各ヨーク27a、27bが上記基板部2、36に対して垂直に配設された状態で、かつ、これらヨーク27a、27bと上記コイルボビン26との間の間隔を十分に確保した状態に調整される。

【0098】ここで、図24に示すように、各ヨーク127a、127bが基板部112上に固定して取付けられている場合には、図24中矢印A及び矢印Bで示す該基板部112上の2次元方向、または、矢印C及び矢印Dで示す該基板部112上での傾き方向にコイルボビン126の位置を調整すると、該各ヨーク127a、12

7bと該コイルボビン126の内壁部との間の間隔が狭くなってしまう。上記各ヨーク127a、127bと上記コイルボビン126の内壁部との間の間隔が狭くなると、このコイルボビン126の上記基板部112に対する移動可能範囲が狭められてしまい、光学ピックアップ装置の正常な動作が阻害される虞れがある。

【0099】また、図25に示すように、調整プレート154と上記各ヨーク127a、127bとを一体化し、この調整プレート154の位置調整に同期して、該各ヨーク127a、127bも上記基板部112上を移動させることとすると、上記コイルボビン126が板バネ124の捻れ等により該調整プレート154に対して傾いて支持されている場合には、該各ヨーク127a、127bと該コイルボビン126の内壁部との間の間隔が狭くなる。

【0100】さらに、上記コイルボビン126が上記基板部112に対して傾いていると、図26に示すように、このコイルボビン126の、下方側、すなわち、上記基板部112側への移動可能ストロークが減少してしまう。上記コイルボビン126の下方側への移動可能ストロークは、このコイルボビン126の上記基板部112への当接により規制されているからである。

【0101】

【発明の効果】上述のように、本発明に係る光学ピックアップ装置においては、主面部にプリント配線パターンが形成され第1の基板部の上面部にこの第1の基板部に沿って取付けられた第2の基板部は、該第1の基板部の側縁部よりも外方側に突出したショートランド部を有し、このショートランド部上に、発光素子の電源供給端子が接続された配線パターンに連続する一方のショートランドとこの一方のショートランドに近接して該発光素子の接地端子が接続された配線パターンに連続する他方のショートランドとを有している。

【0102】したがって、この光学ピックアップ装置においては、輸送、搬送中等においては上記各ショートランド間を半田付けにより短絡（ショート）させておき、使用時には、上記第1の基板部の側縁部に沿って上記第2の基板部のショートランド部を折り取ることで、上記発光素子の電源供給端子と該発光素子の接地端子との短絡を容易に解除することができる。

【0103】すなわち、本発明は、光学ピックアップ装置単体での輸送、搬送中における半導体レーザ素子の静電破壊が確実に防止されるとともに、製造が容易化され、さらに、光ディスク再生装置への組み込みが容易化された光学ピックアップ装置を提供することができるものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る光学ピックアップ装置の構成を示す縦断面図である。

【図2】上記光学ピックアップ装置の概略的な構成を示

す分解斜視図である。

【図3】上記光学ピックアップ装置におけるシェルカバーの基板部への取付け状態の要部を示す要部縦断面図である。

【図4】上記光学ピックアップ装置の基板部の構成を示す平面図である。

【図5】上記光学ピックアップ装置におけるシェルカバーの基板部への取付け状態の要部を示す要部斜視図である。

【図6】上記光学ピックアップ装置のシェルカバーの構成を示す斜視図である。

【図7】上記光学ピックアップ装置のシェルカバーの構成を示す平面図である。

【図8】上記光学ピックアップ装置のシェルカバーの構成を示す縦断面図である。

【図9】上記光学ピックアップ装置のレーザカプラの構成を示す斜視図である。

【図10】上記光学ピックアップ装置における光学部品の位置関係を示す平面図である。

【図11】上記光学ピックアップ装置における光学部品の位置関係を示す縦断面図である。

【図12】上記光学ピックアップ装置におけるレーザカプラの位置調整を示す側面図である。

【図13】上記光学ピックアップ装置における基板部に対するシェルカバーの位置の平面内の誤差を示す平面図である。

【図14】上記光学ピックアップ装置における基板部に対するレーザカプラの位置の平面内の誤差を示す平面図である。

【図15】上記光学ピックアップ装置における光学部品の位置精度を示す縦断面図である。

【図16】上記光学ピックアップ装置における基板部に対するレーザカプラの位置の傾きによる誤差を示す平面図である。

【図17】上記光学ピックアップ装置における光学部品の配置を示す平面図である。

【図18】上記光学ピックアップ装置における基板部の形状を示す平面図である。

【図19】上記光学ピックアップ装置における基板部の形状を示す側面図である。

【図20】上記光学ピックアップ装置の基板部のショートランド部を折曲させた状態を示す側面図である。

【図21】上記光学ピックアップ装置の対物レンズ駆動機構の構成を示す分解斜視図である。

【図22】上記光学ピックアップ装置の対物レンズ駆動機構においてコイルボビンの位置を調整する調整機構の構成を示す分解斜視図である。

【図23】上記光学ピックアップ装置の対物レンズ駆動機構においてコイルボビンの位置を調整する調整機構の構成を示す縦断面図である。

17

【図24】従来の光学ピックアップ装置の対物レンズ駆動機構においてコイルボbinの位置を調整する調整機構の構成を破断して示す斜視図である。

【図25】従来の光学ピックアップ装置の対物レンズ駆動機構においてコイルボbinの位置を調整する調整機構の構成を示す縦断面図である。

【図26】従来の光学ピックアップ装置の対物レンズ駆動機構においてコイルボbinの位置を調整する調整機構の構成を示す正面図である。

【図27】従来の光学ピックアップ装置におけるシェルカバーの基板部への取付け状態の要部を示す要部縦断面図である。

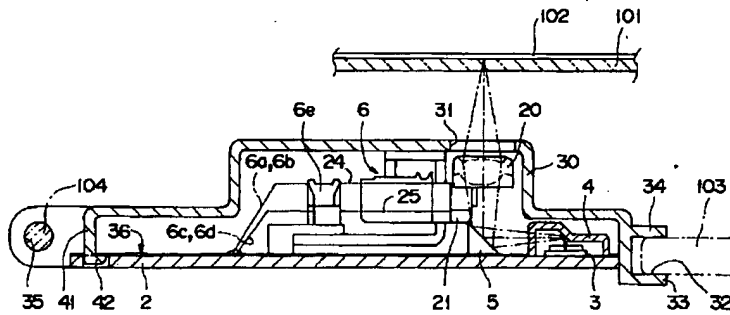
【図28】従来の光学ピックアップ装置におけるシェルカバーの基板部への取付け状態の要部の他の例を示す要

部縦断面図である。

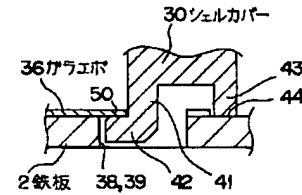
【符号の説明】

2 ベース基板、3 レーザカプラ(L/C)、4 反射ミラー、5 反射プリズム、6 対物レンズ駆動機構、10 半導体レーザー素子、13 半導体基材部、14a 第1の光検出器、14b 第2の光検出器、20 対物レンズ、21 レンズボbin、26 コイルボbin、27a、27b ヨーク、28 マグネット、30 シェルカバー、32 係合溝、35 スラストスリーブ部、36プリント基板、42 当接爪、43 当接杆、44 基準面、46 ショートランド部、47 一方のショートランド、48 他方のショートランド、50 鉤部、52 ベース基板曲げ位置、54 調整プレート、60 可動ヨーク、63、64 係合突起

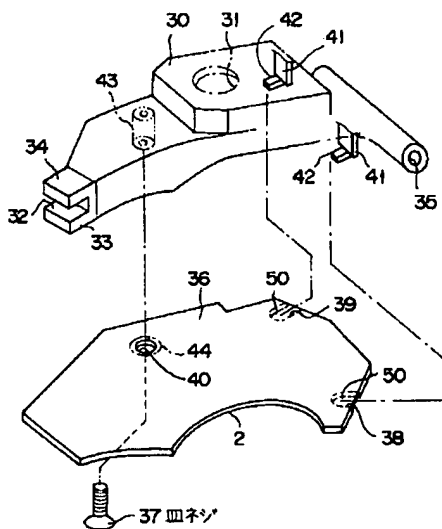
【図1】



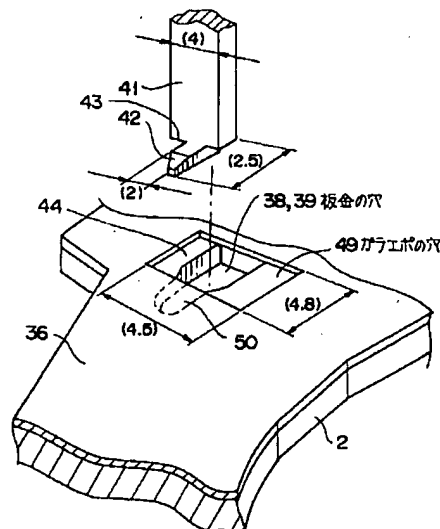
【図3】



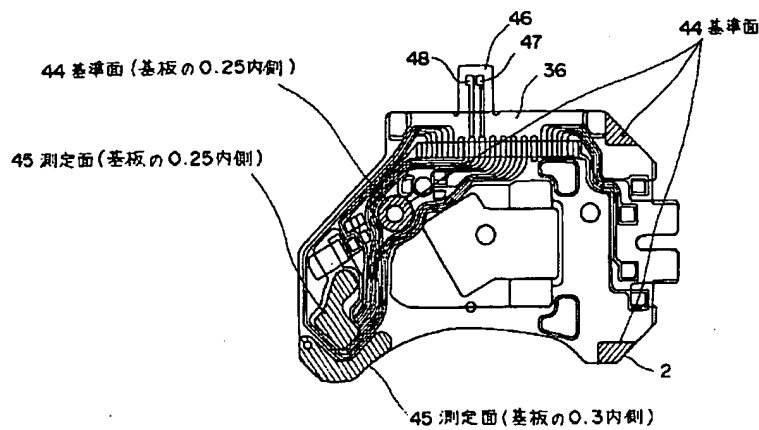
【図2】



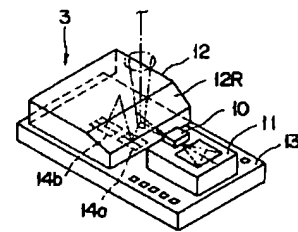
【図5】



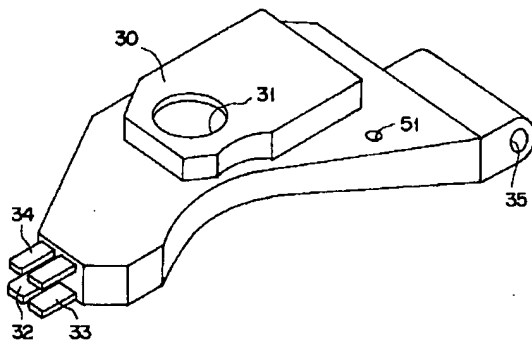
【図4】



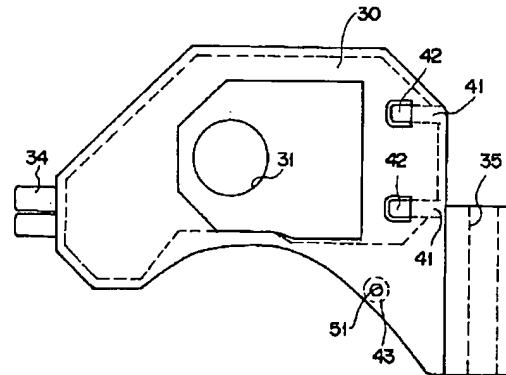
【図9】



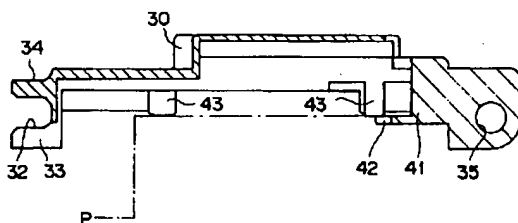
【図6】



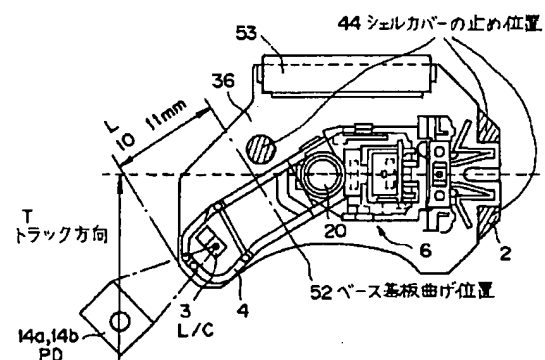
【図7】



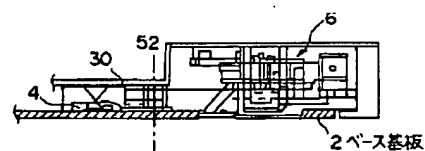
【図8】



【図10】

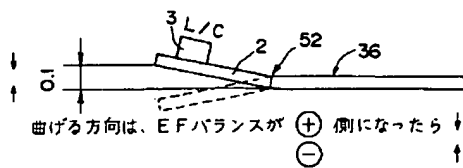


【図11】



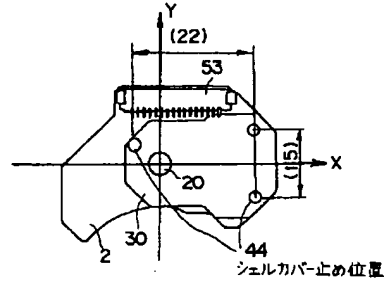
突端で0.1m/m曲げるとして、 $L = 10 \sim 11$ より
 $ASIN (0.1/11) = 0.52^\circ$ で再び調整範囲に入る

【図12】



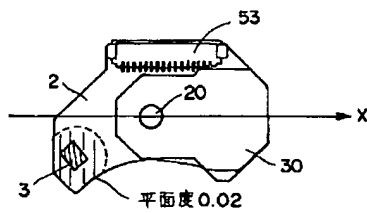
【図13】

X方向角度 $\text{ASIN}(0.05/22) = 0.13^\circ$
 Y方向角度 $\text{ASIN}(0.05/15) = 0.19^\circ$

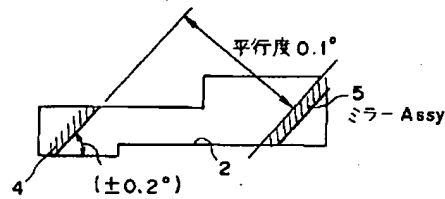


【図14】

X方向角度 $\text{ASIN}(0.02/10) = 0.10^\circ$
 Y方向角度 $\text{ASIN}(0.02/10) = 0.10^\circ$

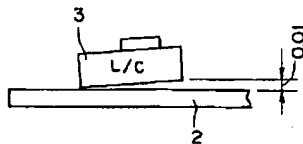


【図15】

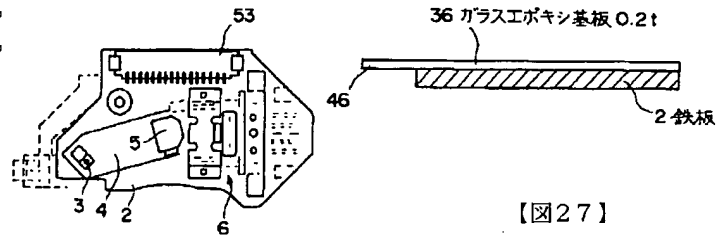


【図16】

X方向角度 $\text{ASIN}(0.01/1.8) = 0.32^\circ$
 Y方向角度 $\text{ASIN}(0.01/3.4) = 0.17^\circ$



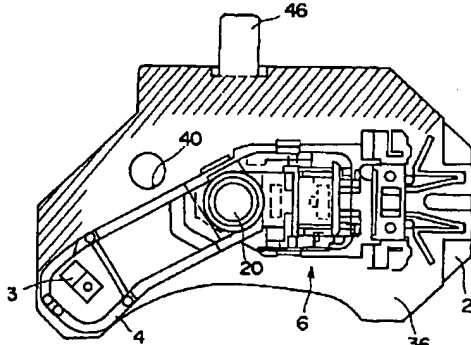
【図17】



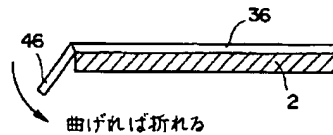
【図19】

【図27】

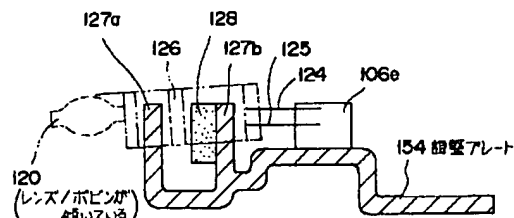
【図18】



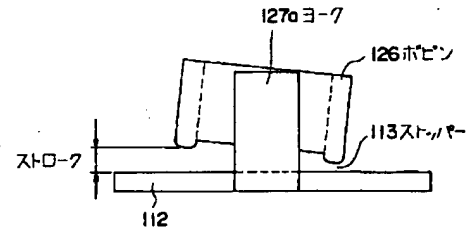
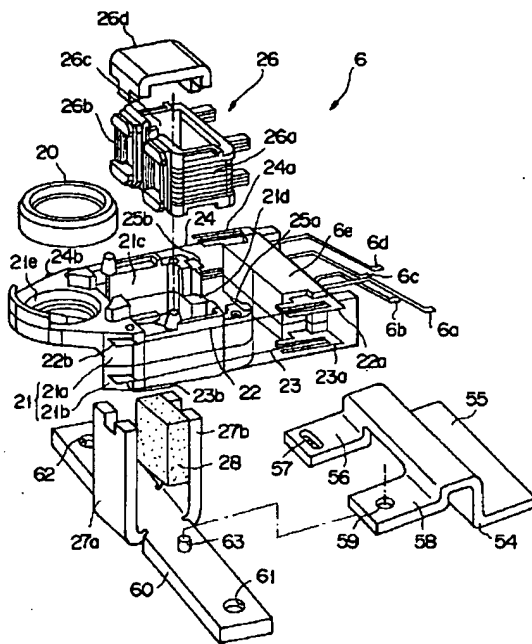
【図20】



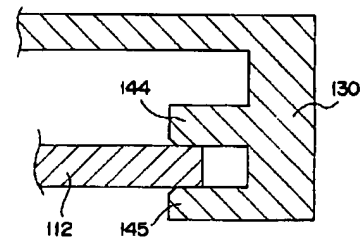
【図25】



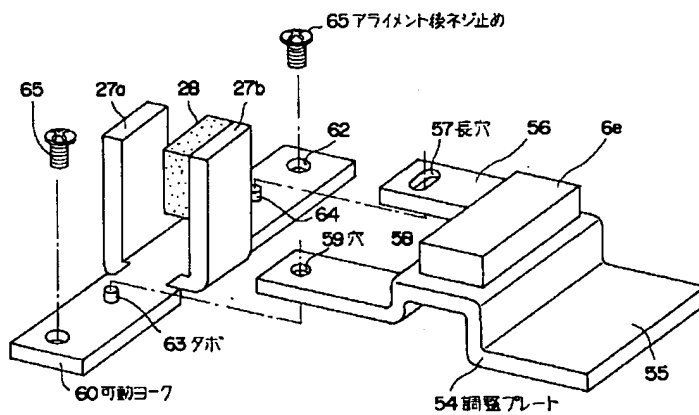
【图26】



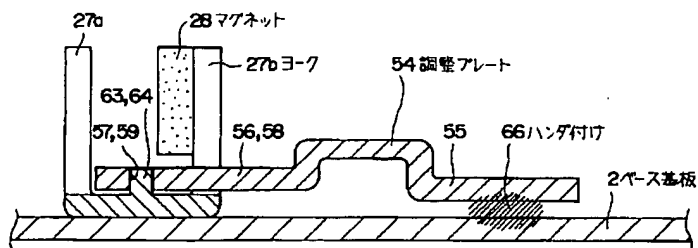
【图28】



【图22】



【図23】



【図24】

